

Opening : 10 : 30 – 10 : 40

1. 10 : 40 – 11 : 00

Energy transfer from REE to Mn in (Sr, Ca)Ga₂S₄ compounds
(Sr,Ca)Ga₂S₄における希土類元素からMnへのエネルギー移動
生内俊光(Toshimitsu Obonai)、日高千晴(Chiharu Hidaka)、滝沢武男(Takeo Takizawa)
日本大学(Nihon university)

2. 11 : 00 – 11 : 20

Photoluminescence property of ZnSnP₂
ZnSnP₂の光学的特性
○K. Miyauchi, T. Minemura, K. Nakatani, H. Nakanishi, M. Sugiyama and *S. Shirakata
○宮内啓輔, 峯村武宏, 中谷圭吾, 中西久幸, 杉山睦, *白方祥
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科、愛媛大学 工学部 電気電子工学科)

3. 11 : 20 – 11 : 40

Analysis of bound-exciton emissions of CuInS₂ crystals
CuInS₂ 結晶の束縛励起子発光の解析
Kazuki Wakita³(登壇者), K. Kishigui¹, YongGu Shim¹, Kenji Yoshino²
脇田和樹¹(登壇者)、岸杭 薫²、沈用 球²、吉野 賢二³
1千葉工大 工、2大阪府大院 工、3宮崎大 工、

4. 11 : 40 – 12 : 00

Effects of proton and gamma-ray irradiation on the optical properties of CuInSe₂ thin films
プロトン・ガンマ線がCuInSe₂の光学特性に与える影響
○T. Yasuniwa, K. Murasawa, A. Umezawa, A. Miyama, H. Nakanishi, *S. F. Chichibu, S. Kimura, M. Sugiyama
○安庭宗弘, 村澤一樹, 梅澤明央, 深山敦, 中西久幸, *秩父重英, 木村真一, 杉山睦
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科), *東北大学 多元物質化学研究所

昼食休憩 12 : 00 – 13 : 00

5. 13 : 00 – 13 : 20

Characterization of Fe 3d states in CuFeS₂ by X-ray emission spectroscopy
「X線発光スペクトルによるCuFeS₂のFe 3d状態の研究」
K. Sato^{1,2}, Y. Harada³, M. Taguchi³, S. Shin³ and A. Fujimori⁴
1 TUAT, 2 JST, 3 SPring-8, 4 Univ. Tokyo
佐藤勝昭、原田慈久、田口宗孝、辛殖、藤森淳
1 農工大、2 JST、3 理研SPring-8、4 東大

6. 13 : 20 – 13 : 40

Electronic structure in stannite-type Cu₂ZnSnSe₄ by first-principle calculations
第一原理計算によるスタナイト型Cu₂ZnSnSe₄の電子構造の評価
登壇者: 中村 哲士 (Satoshi Nakamura)
連名者: 前田 毅 (Tsuyoshi Maeda)、和田 隆博 (Takahiro Wada)
龍谷大学 理工学部 物質化学科

7. 13 : 40 – 14 : 00

Preparation of Ga-doped ZnO transparent conducting films by helicon-wave-excited plasma sputtering
ヘリコン波励起プラズマスパッタ法による透明導電膜Ga添加ZnOの成長
○S. Masaki, H. Nakanishi, M. Sugiyama, *S. F. Chichibu
○政木真悟, 中西久幸, 杉山睦, *秩父重英
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科, *東北大学 多元物質化学研究所

8. 14:00-14:20
ヘリコン波励起プラズマスパッタ法及びRFスパッタ法によるCuAlO₂薄膜成長
○S.Takahata, K.Saiki, T.Imao, H.Nakanishi, M.Sugiyama, *S.F.Chichibu
○高畑覚, 佐伯圭太, 今尾隆, 中西久幸, 杉山睦, *秩父重英
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科, 東北大学 多元物質化学研究所)

9. 14:20-14:40
山梨大 松本先生 予定

10. 14:40-15:00
Growth of Cu(In,Al)Se₂ thin films by selenization using diethylselenide
ジエチルセレンを用いたセレン化によるCu(In,Al)Se₂の成長
○A.Umezawa, T.Yasuniwa, A.Miyama, H.Nakanishi, M.Sugiyama, *S.F.Chichibu
○梅澤明央, 安庭宗弘, 深山敦, 中西久幸, 杉山睦, *秩父重英
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科, *東北大学 多元物質化学研究所)

休憩 15:00-15:20

11. 15:20-15:40
Photoluminescence and time-resolved photoluminescence in Cu(In,Ga)Se₂ thin films and solar cells
Cu(In,Ga)Se₂薄膜太陽電池のフォトルミネッセンスと時間分解フォトルミネッセンス
○S. Shirakata and *T. Nakada
○白方祥, *中田時夫
愛媛大学工学部, *青山学院大学理工学部

12. 15:40-16:00
Fabrication of Zn doped Cu(In,Ga)Se₂ thin film solar cells prepared by thermal diffusion of Zn using dimethylzinc
ジメチル亜鉛を用いてZn添加したCu(In,Ga)Se₂薄膜太陽電池の作製
○A.Miyama, T.Yasuniwa, A.Umezawa, H.Nakanishi, M.Sugiyama, *S.F.Chichibu
○深山敦, 安庭宗弘, 梅澤明央, 中西久幸, 杉山睦, *秩父重英
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科, *東北大学 多元物質化学研究所

13. 16:00-16:20
Preparation of SnS films by Sulfurization and Fabrication of SnS-related Solar Cell
SnS薄膜の硫化成長とSnS系太陽電池の試作
○T.Minemura, K.Miyauchi, K.Noguchi, K.Ohtsuka, H.Nakanishi, M.Sugiyama
○峯村武宏, 宮内啓輔, 野口康次, 大塚憲一, 中西久幸, 杉山睦
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科

Closing 16:20-16:30